

半 导 体 学 报

第 6 卷 第 2 期 1985 年 3 月

目 录

- B 样条函数在短沟道 MOS 器件直流特性模拟中的应用 严志新 (113)
- 780°C 下液相外延生长 $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ 的生长和掺杂特性
..... 余金中 岩井莊八 青柳克信 (123)
- 用 RDLTS 方法研究 P 型硅中 Yb 的空穴发射率与电场的关系
..... 鲁永令 傅春寅 曾树荣 (128)
- 混晶半导体中深能级的展宽及其有关效应 王占国 (132)
- 以空穴层为表面层的第 II 类半无限半导体超晶格中的表面集体激发模式
..... 秦国毅 (142)
- 多晶硅薄膜干氧化特性的研究 张爱珍 王阳元 (150)
- 用冷阴极电子束快速处理金属-硅薄膜生成硅化物
..... 杜元成 鲁 钟 郁曾期 孙迭麓 李富铭 G. J. Collins (159)
- InP 氯化物气相外延的热力学分析 陆大成 (166)
- 注砷硅超固溶度热弛豫特性的沟道研究
..... 王豫生 阎建华 郑胜男 徐 立 钱佩信 (173)

研 究 简 报

- 光电化学法测量 GaAlAs/GaAs 多层结构材料中 Al 组分分布
..... 陈自姚 邵永富 朱福英 彭瑞伍 (181)
- 用 CCWT 方法确定少子的体产生寿命及表面产生速度 谭长华 许铭真 (185)
- 氧在 InP(111) 面上吸附的 CLS、AES 和 XPS 研究 戴道宣 朱福荣 (190)
- 用光声谱法研究硅单晶中 $^{31}\text{P}^+$ 离子注入 苏九令
包宗明 王昌平 陆桂华 倪 玫 陈 肯 杨中柱 黄正义 吴树恩 (195)
- 微波凹槽栅结构 GaAs FET's 的最佳凹槽深度的选择的讨论 汪正孝 (199)
- 在蓝宝石上低温外延硅 杨光荣 王向明 秦复光 (203)
- 用压电传感器研究半导体中的电子-声子的相互作用
..... 李增发 张光寅 钱 华 王文斌 (208)
- Pt/InP 界面反应形成磷化铂的证据 戴道宣 唐厚舜 姜国宝 (212)
- a-Si:H 样品的光诱导光电导可逆变化和红外振动吸收
..... 戴国才 余亦舜 周玉芳 张德俊 张仪凤 马洪磊 罗文秀 (218)

学 术 讨 论

- 评“ K_{CMR} 的一个测试方法” 易明铤 (221)